









	<b>FDP045N10A</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FDP045N10A
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3
	<b>Datenblätter:</b>	 FDP045N10A.pdf
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 21309 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP045N10A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	21309 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 120A (Tc) 263W (Tc) Through Hole
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	263W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 100A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5270pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP045N10A ist neu im Original, Suche FDP045N10A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP045N10A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP045N10A: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FDP040N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO220	 <b>FDP040N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO220	 <b>FDP039N08B-F102</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 80V 120A TO-220	 <b>FDP045N10A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3
 <b>FDP047AN08A0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB	 <b>FDP047AN08</b> FAIRCHILD FDP047AN08 FAIRCHILD	 <b>FDP039N08B_F102</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 80V 120A TO-220	 <b>FDP040N08</b> Fairchild/ON Semiconductor FDP040N08 FAIRCHILD

### heiße Teile

Mehr

 FDP020N06B	 FDP023N08B	 FDP025N06	 FDP025N06	 FDP027N08B
 FDP027N08B	 FDP030N06	 FDP030N06	 FDP030N06B_F102	 FDP032N08
 FDP032N08	 FDP032N08B	 FDP036N10A	 FDP036N10A	 FDP038AN06A0
 FDP038AN06A0	 FDP038AN06A0	 FDP039N08B	 FDP040N06	 FDP040N06
 FDP045N10A	 FDP047AN08	 FDP047AN08A0	 FDP047AN08A0	 FDP047AN08A0
 FDP047N08	 FDP047N08	 FDP047N08A0	 FDP047N10	 FDP047N10
 FDP050AN06A0	 FDP050AN06A0	 FDP050AN06A0	 FDP053N08B	 FDP053N08B_F102
 FDP054N10	 FDP054N10	 FDP060AN08A0	 FDP060AN08A0	 FDP060AN08A0
 FDP060N08A0	 FDP060N08A0	 FDP068AN08A0	 FDP070AN06A0	 FDP070AN06A0
 FDP070AN06A0	 FDP075N15A	 FDP075N15A	 FDP083N15A	 FDP083N15A

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited